

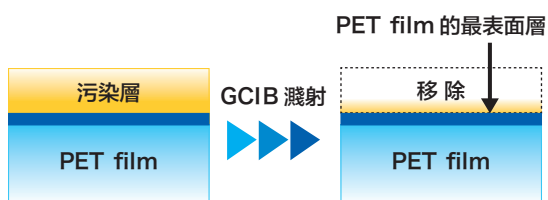
GCIB-TOF-SIMS

有機層的組成構造解析

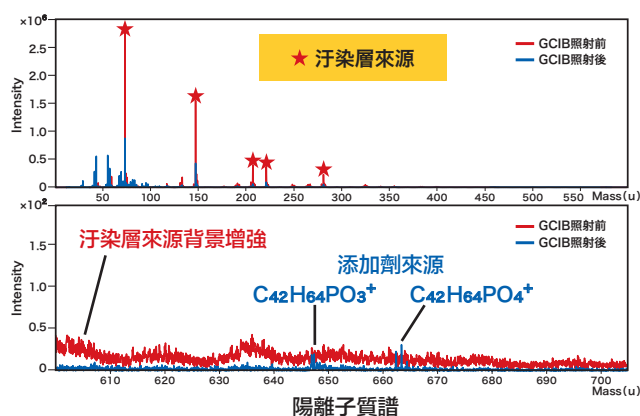
有機材料的低損害測定

表面污染薄膜中的添加劑分析

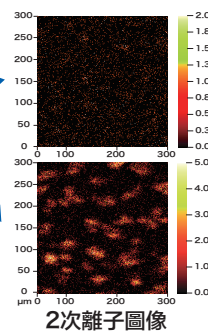
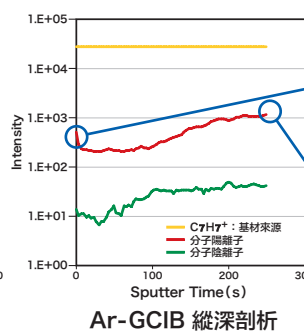
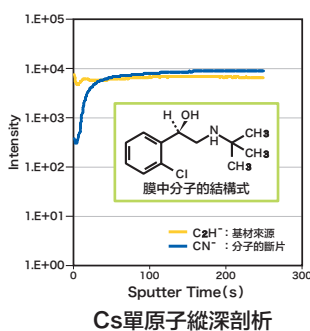
將最表面的污染層以 Ar-GCIB 去除後，便能降低損害薄膜表面暴露出來。此面再經由 TOF-SIMS 測定，即能正確掌握污染前的薄膜表面狀態。



經 GCIB 照射處理後，不但減少了來自污染層的雜訊，也能測出來自添加劑的雜訊。明確分離污染前薄膜表面之添加劑。

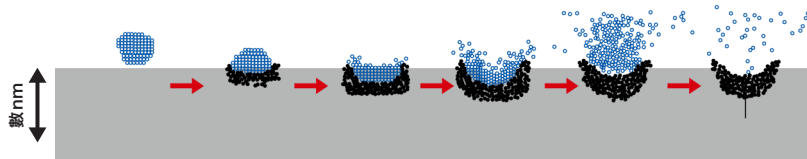
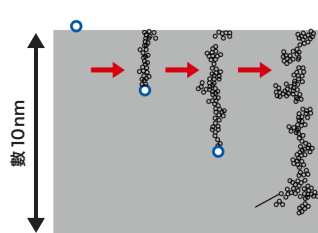


有機薄膜中的組成分布解析



以 GCIB 朝縱深方向解析，除了可檢出來自化合物的分子、離子，也能了解其內部測的濃度較高。進一步由圖型化的測定得知表面均一性的分布結果。

Ar-gas cluster ion beam (Ar-GCIB)



與單原子濺射不同，GCIB（氣體團簇離子素）濺射僅損害極表面。濺射（微損害）後的表面分析仍可進行評價。